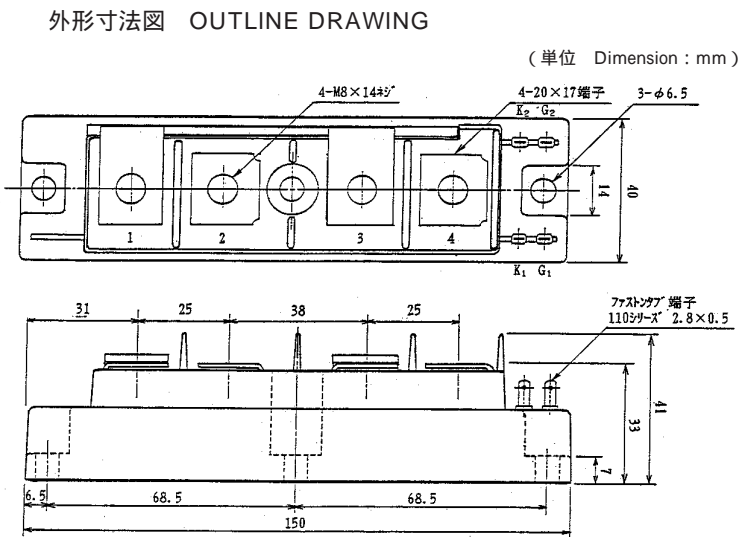
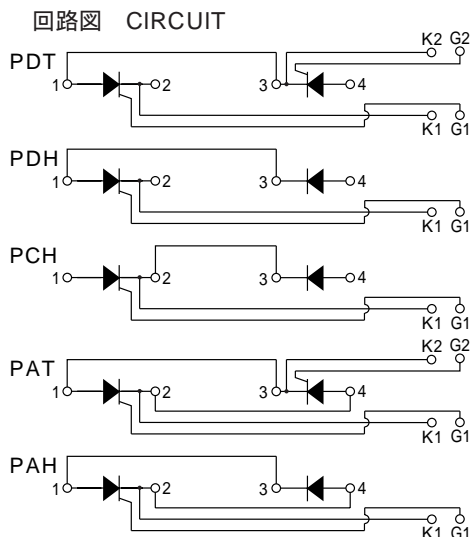


THYRISTOR 200A Avg 800 Volts

PDT
 PDH
 PCH
 PAT
 PAH



最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐压クラス Grade	単位 Unit
		PDT2008/PDH2008/PCH2008/PAT2008/PAH2008	
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DRM}	800	V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DSM}	900	V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	800	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	900	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit		
平均整流電流 Average Rectified Output Current	$I_{O(AV)}$	商用周波数 180° 通電 $T_c = 65$ Half Sine Wave	200	A		
実効オン電流 RMS On-State Current	$I_{T(RMS)}$		314	A		
サージオン電流 Surge On-State Current	I_{TSM}	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	4000	A		
電流二乗時間積 I Squared t	I^2t	2 ~ 10ms	80000	A^2s		
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	$V_D = 2/3 V_{DRM}$, $I_{TM} = 2 \cdot I_O$, $T_j = 125$ $I_G = 300mA$, $di_G/dt = 0.2A/\mu s$	100	A/ μs		
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P_{GM}		5	W		
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	$P_{G(AV)}$		1	W		
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I_{GM}		2	A		
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V_{GM}		10	V		
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V_{RGM}		5	V		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}		- 40 ~ + 125			
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}		- 40 ~ + 125			
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V_{iso}	端子 - ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1 min.	2000	V		
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5 ~ 3.5	N·m
	主端子部 Terminal		M8	9.0 ~ 10.0	N·m	

1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

電氣的特性 Electrical Characteristics

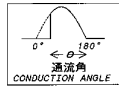
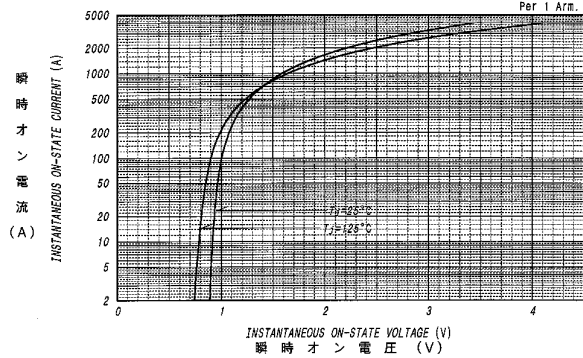
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	I _{DM}	T _j =125 , V _{DM} =V _{DRM}			30	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I _{RM}	T _j =125 , V _{RM} =V _{RRM}			30	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V _{TM}	T _j =25 , I _{TM} =600A			1.34	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I _{GT}	V _D =6V , I _T =1A	T _j = - 40		300	mA
			T _j = 25		150	mA
			T _j = 125		80	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V _{GT}	V _D =6V , I _T =1A	T _j = - 40		5	V
			T _j = 25		3	V
			T _j = 125		2	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V _{GD}	T _j =125 , V _D =2/3V _{DRM}	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	T _j =125 , V _D =2/3V _{DRM}	500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t _q	T _j =125 , I _{TM} =I _O , V _D =2/3V _{DRM} dv/dt=20V/μs , V _R =100V , - di/dt=20A/μs		100		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	t _{gt}			6		μs
遅れ時間 Delay Time	t _d	T _j =25 , V _D =2/3V _{DRM} I _G =300mA , di _G /dt=0.2A/μs		2		μs
立上がり時間 Rise Time	t _r			4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I _L	T _j =25		100		mA
保持電流 Holding Current	I _H	T _j =25		60		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部 - ケース間 Junction to Case			0.23	/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(c-f)}	ケース - フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased			0.1	/W

質量...約480g
Approximate Weight

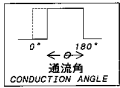
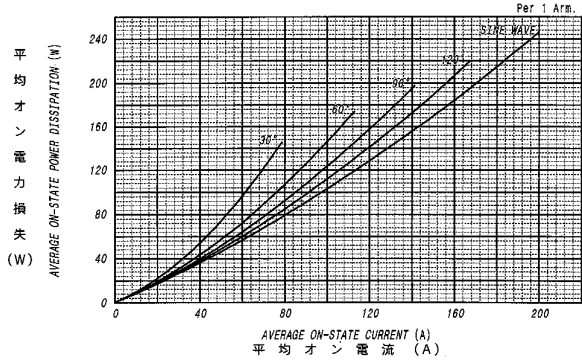
1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

定格・特性曲線

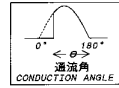
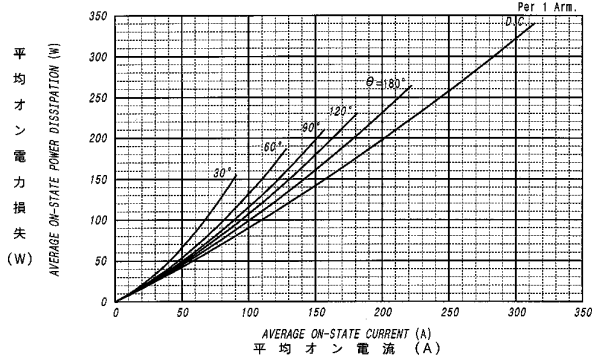
オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE



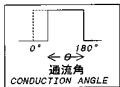
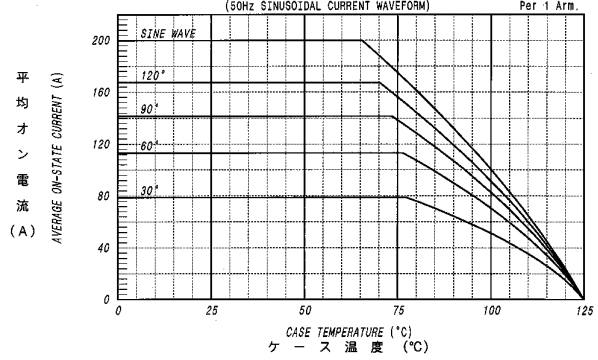
平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION
for SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM



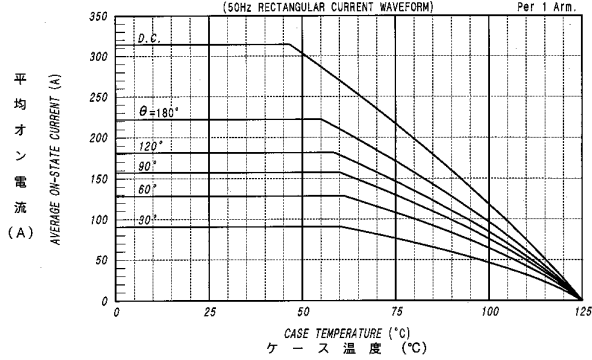
平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION
for RECTANGULAR CURRENT WAVEFORM



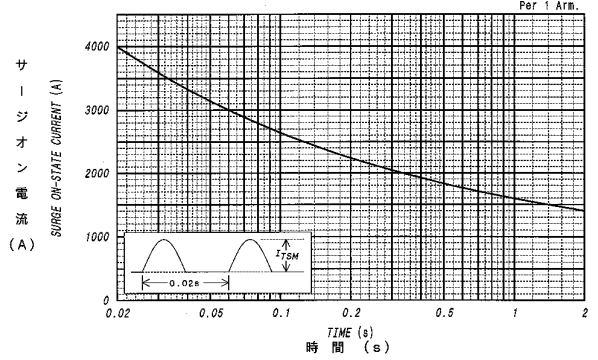
平均オン電流 - ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



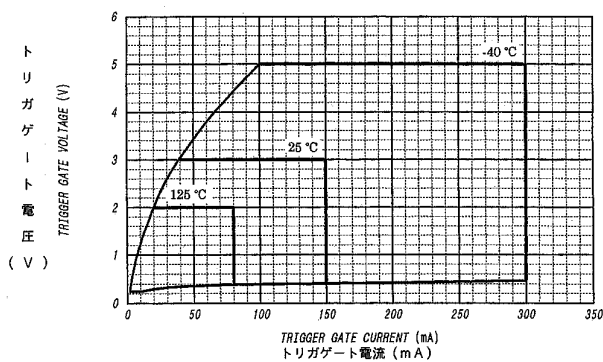
平均オン電流 - ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



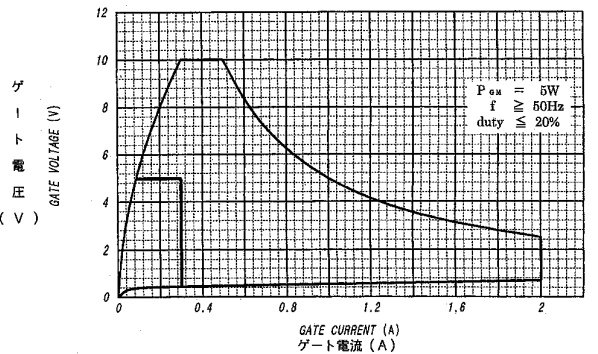
サージオン電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

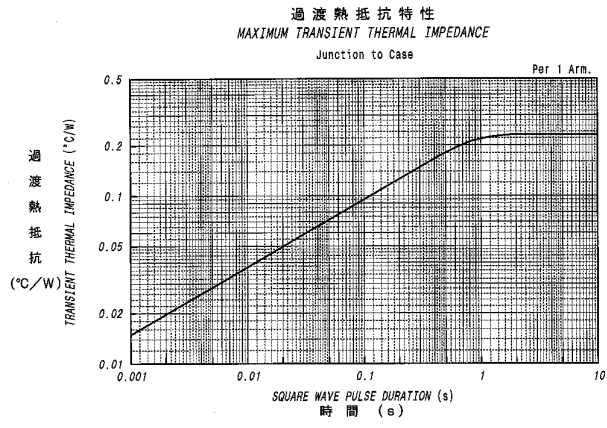


ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS



ゲート定格
GATE RATINGS





サイリスタモジュール